

08.12.2004

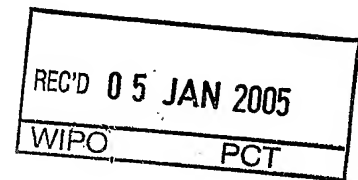
日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 1 2 月 9 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 4 1 0 0 9 7
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 4 1 0 0 9 7]



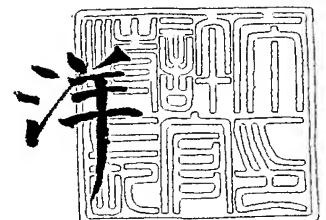
出 願 人 昭和電工株式会社
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 1 0 月 2 6 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 SDP4856
【提出日】 平成15年12月 9日
【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿
【国際特許分類】 H05B 33/00
C09K 11/00

【発明者】
【住所又は居所】 千葉県千葉市緑区大野台一丁目 1 番 1 号 昭和電工株式会社 研
究開発センター内
【氏名】 小山 珠美

【発明者】
【住所又は居所】 千葉県千葉市緑区大野台一丁目 1 番 1 号 昭和電工株式会社 研
究開発センター内
【氏名】 近藤 邦夫

【特許出願人】
【識別番号】 000002004
【住所又は居所】 東京都港区芝大門一丁目 1 3 番 9 号
【氏名又は名称】 昭和電工株式会社
【代表者】 大橋 光夫

【代理人】
【識別番号】 100081086
【弁理士】
【氏名又は名称】 大家 邦久
【電話番号】 03(3669)7714

【代理人】
【識別番号】 100117732
【弁理士】
【氏名又は名称】 小澤 信彦

【代理人】
【識別番号】 100121050
【弁理士】
【氏名又は名称】 林 篤史

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 043731
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 0213106

【書類名】 特許請求の範囲

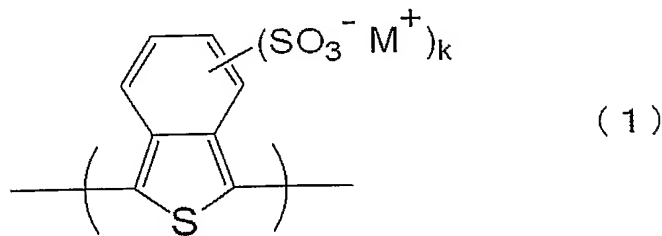
【請求項 1】

1 質量%水溶液における pH が 3～7 である自己ドープ型導電性高分子からなることを特徴とする有機発光素子の陽極バッファ層用重合体。

【請求項 2】

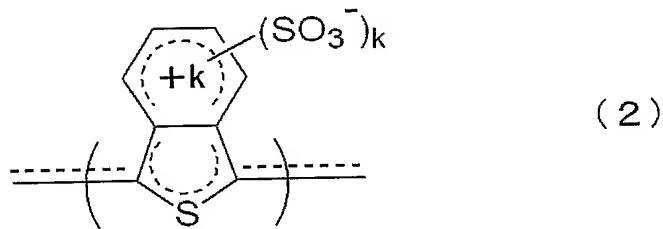
式 (1)

【化 1】



〔式中、 M^+ は水素イオン、アルカリ金属イオンまたは第 4 級アンモニウムイオンを表わし、 k は 1 または 2 である。また、芳香環上の水素が結合している位置は置換基で置換されていてもよい。〕 及び／または式 (2)

【化 2】



〔式中、 k は 1 または 2 であり、 $+k$ は正電荷の数を表わし、芳香環上の水素が結合している位置は置換基で置換されていてもよい。〕

で示されるモノマー単位を含む請求項 1 に記載の陽極バッファ層用重合体。

【請求項 3】

重量平均分子量が 1,000～200,000 である請求項 2 に記載の陽極バッファ層用重合体。

【請求項 4】

請求項 1 乃至 3 のいずれかに 1 項に記載の重合体を含む有機発光素子の陽極バッファ層塗布用溶液。

【請求項 5】

一対の陽極と陰極の間に、少なくとも一層の発光層を有する有機発光素子において、前記陽極に隣接する層が請求項 1 乃至 3 のいずれかに 1 項に記載の陽極バッファ層用重合体を含む陽極バッファ層である有機発光素子。

【請求項 6】

前記発光層が蛍光発光性高分子材料からなる請求項 5 に記載の有機発光素子。

【請求項 7】

前記発光層が燐光発光性高分子材料からなる請求項 5 に記載の有機発光素子。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 陽極バッファ層用重合体、陽極バッファ層塗布用溶液及び有機発光素子

【技術分野】

【0001】

本発明は有機発光素子 (Organic Light Emitting Device; 以下 OLED と略記することがある。) の陽極バッファ層に関する。さらに詳しく言えば、有機発光素子 (OLED) の陽極バッファ層用重合体、その重合体を含む有機発光素子の陽極バッファ層塗布用溶液、及び前記重合体を用いた陽極バッファ層を有する有機発光素子に関する。

【背景技術】

【0002】

現在開発されている高分子型有機発光素子の素子構成としては、透明基板側から順次、陽極 (透明) / 陽極バッファ層 / 発光層 / 陰極を設けたものが代表的である。ここで、陽極バッファ層は陽極表面を平坦化して電氣的短絡防ぐ目的、また発光層から陽極へのホール注入に対する注入障壁を緩和する目的で挿入される。

この陽極バッファ層としては、現在、導電性高分子材料であるポリ (3, 4-エチレンジオキシチオフェン) (PEDOT) とポリスチレンスルホン酸 (PSS) の混合体が広く用いられている。しかし、この陽極バッファ層には、外来ドーパントとして含まれているポリスチレンスルホン酸が発光層に侵入して発光層を劣化させるという問題点が存在する。

【0003】

このような陽極バッファ層中に含まれる外来ドーパントが引き起こす問題に関しては、特表 2 0 0 3 - 5 0 9 8 1 6 号公報 (特許文献 1) に外来ドーパントを含まない自己ドーブ型導電性高分子を陽極バッファ層に用いる方法が開示されている。同公報には、自己ドーブ型導電性高分子のバックボーンを形成しうる好適な真性導電性高分子として、ポリアニリン類、ポリ (フェニレンビニレン) 類、ポリチオフェン類、ポリイソチアナフテン類、ポリ (p-フェニレン) 類などが例示されている。また、好適な自己ドーブ型導電性高分子としては、自己ドーブ型ポリアニリン、自己ドーブ型ポリピロール、自己ドーブ型ポリチオフェンを挙げており、中でも自己ドーブ型スルホン化ポリアニリンについての実施形態及び実施例を挙げて最も好ましいとしている。

【0004】

【特許文献 1】 特表 2 0 0 3 - 5 0 9 8 1 6 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

上記のように、従来の陽極バッファ層の外来ドーパントによる発光層劣化の問題に対しては、特表 2 0 0 3 - 5 0 9 8 1 6 号公報に自己ドーブ型スルホン化ポリアニリンを陽極バッファ層として使用することが提案されているが、ポリアニリン自体の導電性が $10^{-1} \sim 10^{-3} \text{ S/cm}$ 程度と陽極バッファ層として満足できるレベルではなく、また塗布溶液として用いる水溶液の酸性度が高い状態 (pH 3 以下) でしか十分な導電性を示さない。

さらに、同公報に好適な例として示されている他の導電性高分子構造については実施形態は全く示されていない。従って、陽極バッファ層の外来ドーパントによる発光層劣化の問題に対しては、現状では自己ドーブ型導電性高分子の使用が提案されてはいるものの、実際の素子で使用可能なものは存在しない。

そこで、本発明では、上記のような高分子型有機発光素子における陽極バッファ層の問題点に対し、実用に耐える陽極バッファ層用の自己ドーブ型導電性高分子材料及びこれを用いた有機発光素子を提供することを課題の一つとする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

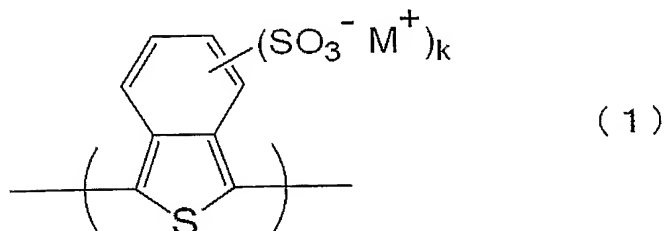
本発明者らは、上記の課題を解決すべく種々検討した結果、水溶液状態における酸性度が低い自己ドーピング型導電性高分子材料を陽極バッファ層として用いた場合に素子特性が改善されることを見出し、本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は、以下の有機発光素子に関する。

1. 1質量%水溶液におけるpHが3～7である自己ドーピング型導電性高分子からなることを特徴とする有機発光素子の陽極バッファ層用重合体。

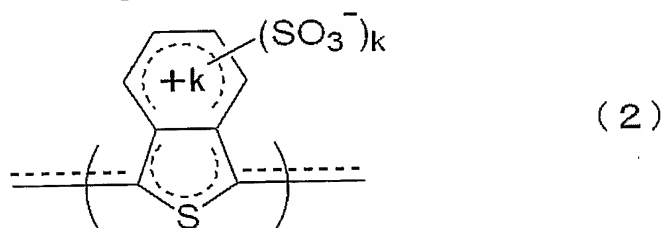
2. 式(1)

【化1】



〔式中、 M^+ は水素イオン、アルカリ金属イオンまたは第4級アンモニウムイオンを表わし、 k は1または2である。また、芳香環上の水素が結合している位置は置換基で置換されていてもよい。〕及び／または式(2)

【化2】



〔式中、 k は1または2であり、 $+k$ は正電荷の数を表わし、芳香環上の水素が結合している位置は置換基で置換されていてもよい。〕

で示されるモノマー単位を含む前記1に記載の陽極バッファ層用重合体。

3. 重量平均分子量が1,000～200,000である前記2に記載の陽極バッファ層用重合体。

4. 前記1乃至3のいずれかに1項に記載の重合体を含む有機発光素子の陽極バッファ層塗布用溶液。

5. 一对の陽極と陰極の間に、少なくとも一層の発光層を有する有機発光素子において、前記陽極に隣接する層が前記1乃至3のいずれか1項に記載の陽極バッファ層用重合体を含む陽極バッファ層である有機発光素子。

6. 前記発光層が蛍光発光性高分子材料からなる前記5に記載の有機発光素子。

7. 前記発光層が燐光発光性高分子材料からなる前記5に記載の有機発光素子。

【発明を実施するための最良の形態】

【0007】

以下、本発明の実施の形態について図を参照して具体的に説明する。

図1は本発明の有機発光素子構成の一例を示す断面図であり、透明基板上に設けた陽極と陰極の間に陽極バッファ層、発光層を順次設けたものである。また、本発明の有機発光素子構成は図1の例のみに限定されず、陽極と陰極の間に順次、1)陽極バッファ層／ホール輸送層／発光層、2)陽極バッファ層／発光層／電子輸送層、3)陽極バッファ層／ホール輸送層／発光層／電子輸送層、4)陽極バッファ層／ホール輸送材料、発光材料、電子輸送材料を含む層、5)陽極バッファ層／ホール輸送材料、発光材料を含む層、6)陽極バッファ層／発光材料、電子輸送材料を含む層、を設けた素子構成などを挙げることができる。また、図1に示した発光層は1層であるが、発光層を2層以上有していてもよい。

【0008】

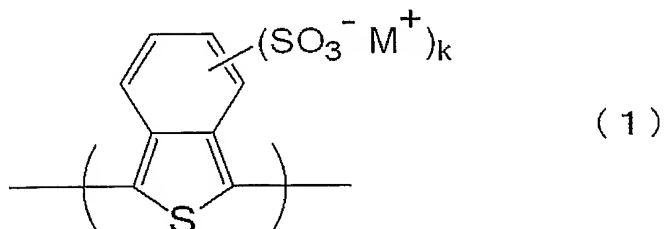
本発明の第1の形態は、1質量%水溶液におけるpHが3～7である自己ドーピング型導電性高分子から成る陽極バッファ層用重合体を提供するものである。

自己ドーピング型導電性高分子の1質量%の水溶液におけるpHの更に好ましい範囲は4～6である。

【0009】

本発明の第1の形態における陽極バッファ層用重合体の好適な化学構造としては、例えば、式(1)で示されるモノマー単位、

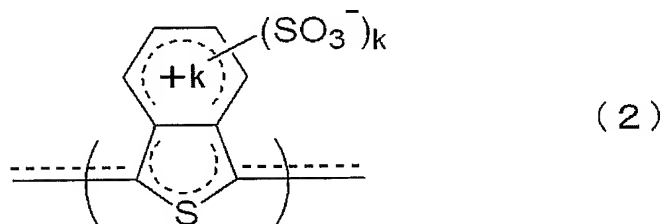
【化3】



〔式中、 M^+ は、水素イオン、アルカリ金属イオン、または第4級アンモニウムイオンを示す。 k は1または2である。〕

及び/またはこれを電気化学的にドーピングすることにより得られる、式(2)で示されるモノマー単位から成る重合体を挙げることができる。

【化4】



〔式中、 k は1または2であり、 $+k$ は正電荷の数を表す。〕

【0010】

式(1)及び式(2)で示されるモノマー単位はスルホン酸基を1個または2個有するが、結合する位置は、4位、5位、6位、7位のいずれであってもよい。

式(1)における M^+ は、水素イオン、アルカリ金属イオン、第4級アンモニウムイオンを表すが、これらのカチオンのうち異なるものを二種類以上含む混合物であっても良い。

【0011】

アルカリ金属イオンとしては、例えば Na^+ 、 Li^+ 、 K^+ が挙げられる。

第4級アンモニウムイオンは、 $N(R^1)(R^2)(R^3)(R^4)^+$ で示される。 $R^4 \sim R^7$ はそれぞれ独立して水素原子、炭素数1～30の直鎖状もしくは分岐状の置換もしくは非置換アルキル基、または置換もしくは非置換アリール基を表わし、アルコキシ基、ヒドロキシ基、オキシアリレン基、チオアリレン基、アゾ基、アゾベンゼン基、p-ジフェニレンオキシ基のごとき炭素、水素以外の元素を含む基を含むアルキルまたはアリール基であってもよい。

【0012】

このような $N(R^1)(R^2)(R^3)(R^4)^+$ で表わされる第4級アンモニウムのカチオンとしては、例えば NH_4^+ 、 $NH(CH_3)_3^+$ 、 $NH(C_6H_5)_3^+$ 、 $N(CH_3)_2(C_6H_4OH)(CH_2-Z)^+$ 等の非置換またはアルキル置換もしくはアリール置換型カチオンが用いられる(但し、 Z は化学式量が600以下の任意の置換基を表し、例えば、フェノキシ基、p-ジフェニレンオキシ基、p-アルコキシジフェニレンオキシ基、p-アルコキシフェニルアゾフェノキシ基等の置換基である。)。なお、通常のイオン交換樹脂を用いて特定のカチオンに変換することができる。

【0013】

$R^1 \sim R^4$ のアルキル基の鎖中には、カルボニル結合、エーテル結合、エステル結合、アミド結合、スルフィド結合、スルフィニル結合、スルホニル結合、イミノ結合等を任意に含んでもよい。

【0014】

式(2)で示されるモノマー単位は式(1)で示されるモノマー単位を電気化学的に酸化ドーピングすることにより得られるものである。これは自己ドーブされた状態であり、芳香環及び主鎖部分に広がる $+k$ の電荷とスルホン酸基の $-k$ の電荷により電気的中性の条件が保たれている。

【0015】

式(1)及び式(2)で示されるモノマー単位は置換基を有していてもよい。置換基が結合する位置は、スルホン酸基が結合した位置を除く4位、5位、6位、7位のうちのいずれでもよく、同じ置換基または異なる置換基が複数結合していてもよい。

【0016】

具体的な置換基の種類としては、炭素数1~20の直鎖状もしくは分岐状の飽和または不飽和のアルキル基、炭素数1~20の直鎖状もしくは分岐状の飽和または不飽和のアルコキシ基、水酸基、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、トリハロメチル基、フェニル基、置換フェニル基を挙げることができる。ここで、前記アルキル基及び前記アルコキシ基の鎖中には、カルボニル結合、エーテル結合、エステル結合、スルホン酸エステル結合、アミド結合、スルホンアミド結合、スルフィド結合、スルフィニル結合、スルホニル結合、イミノ結合、チオエーテル結合を任意に含有してもよい。

【0017】

本発明の式(1)または式(2)で示される化学構造の好ましい具体例としては、5-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイル、4-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイル、4-メチル-5-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイル、6-メチル-5-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイル、6-メチル-4-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイル、5-メチル-4-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイル、6-エチル-5-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイル、6-プロピル-5-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイル、6-ブチル-5-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイル、6-ヘキシル-5-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイル、6-デシル-5-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイル、6-メトキシ-5-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイル、6-エトキシ-5-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイル、6-クロロ-5-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイル、6-ブロモ-5-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイル、6-トリフルオロメチル-5-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイル等、もしくはそれらのリチウム塩、ナトリウム塩、アンモニウム塩、メチルアンモニウム塩、エチルアンモニウム塩、ジメチルアンモニウム塩、ジエチルアンモニウム塩、トリメチルアンモニウム塩、トリエチルアンモニウム塩、テトラメチルアンモニウム塩、テトラエチルアンモニウム塩等を挙げることができる。

【0018】

本発明の陽極バッファ層用重合体は、上記式(1)または式(2)で示される1種類のモノマー単位からなる単一重合体であってもよく、また式(1)または式(2)で示される複数種類のモノマー単位から成る共重合体であってもよく、更には式(1)または式(2)で示される1種類以上のモノマー単位と、スルホン酸基を有しない π 電子共役系の1種類以上のモノマー単位との共重合体であってもよい。

【0019】

前記スルホン酸基を有しない π 電子共役系のモノマー単位としては、ビニレン、イソチアナフテニレン、イソベンゾフリレン、イソベンゾインドリレン、チエニレン、ピロリレン、フリレン、イミノフェニレン、フェニレンなどを例示することができる。また、これらのモノマー単位が複数種類含まれていてもよい。

【0020】

本発明の陽極バッファ層用重合体はスルホン酸基を有するため、水溶性の性質が現れ、スルホン酸基を多く有するほど水溶性の程度も大きくなる。陽極バッファ層用重合体が水溶性で有機溶媒に不溶であるということは、現在使用しうる高分子系発光材料の殆どが有機溶剤に可溶で水には不溶であることから、陽極バッファ層の上に発光層を塗布により積層することを可能にするもので、有機発光素子を作製する上で極めて有利な点である。

【0021】

本発明の陽極バッファ層用重合体が、上記式(1)または式(2)で示される1種類以上のモノマー単位と、スルホン酸基を有しない π 電子共役系の1種類以上のモノマー単位との共重合体である場合には、重合体全体に対する上記式(1)または式(2)で示されるモノマー単位の合計のモル分率は0.2~1の範囲が好ましく、0.5~1の範囲がより好ましい。

【0022】

本発明の陽極バッファ層用重合体は式(1)及び/または式(2)で示されるモノマー単位を含むものであるが、式(2)で示されるモノマー単位の割合、すなわち自己ドーピング状態のモノマー単位の割合が多いほど導電性が高くなり、低電圧でホールが注入できるため、素子の駆動電圧を低下させることが可能となる。しかし、たとえ陽極バッファ層用重合体に式(2)で示されるモノマー単位が全くなく、式(1)で示されるモノマー単位しかない場合でも、実際に有機発光素子を作製して通電した場合には、陽極から陽極バッファ層へホールが注入されるため、陽極バッファ層中の式(1)で示されるモノマー単位は酸化されてドーピング状態、すなわち式(2)で示されるモノマー単位に変換される。従って、式(1)で示されるモノマー単位のみからなる重合体も本発明の陽極バッファ層として使用できるものであり、式(1)及び/または式(2)で示されるモノマー単位を含むものであれば、本発明の陽極バッファ層として特に制限なく使用することができる。

【0023】

本発明に使用される自己ドーピング型の重合体の分子量は、重量平均分子量で1,000~200,000の範囲が好ましく、5,000~100,000の範囲がより好ましい。

本発明に使用される自己ドーピング型の重合体の特に好ましい具体例としては、5-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイルの重合体、5-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイルを80モル%以上含有するランダムコポリマー、ポリ(5-スルホイソチアナフテン-1, 3-ジイル-co-イソチアナフテン-1, 3-ジイル)等とそれらのリチウム塩、ナトリウム塩、アンモニウム塩、トリエチルアンモニウム塩等を挙げることができる。

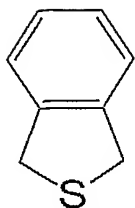
【0024】

本発明の陽極バッファ層用重合体の中で、式(1)または式(2)で示されるモノマー単位からなる単一重合体であるポリ(イソチアナフテンスルホン酸)は、他の公知のスルホン酸を有する導電性高分子、例えばアルカンスルホン酸基を有するポリチオフェン誘導体やポリアニリン誘導体などと比較して、半導体としてのバンドギャップが約1.0 eVと小さく、低いドーピングレベルで導電性を示し、その導電状態が極めて安定に得られるという特徴を有する。そのため、特にドーピング時には可視光の吸光度が小さくなるため、安定性の優れた透明な陽極バッファ層が得られる。

【0025】

式(1)及び/または式(2)で示されるモノマー単位からなる重合体、及び式(1)または式(2)で示される1種類以上のモノマー単位とスルホン酸基を有しない π 電子共役系の1種類以上のモノマー単位との共重合体は、特開平6-49183号公報及び特開平7-48438号公報に開示されている方法に従って製造することができる。上記公報の方法によれば、式(1)及び/または式(2)で示されるモノマー単位からなる重合体は、式(3)または式(4)で示される化合物を発煙硫酸のようなスルホン化剤と反応させることによって製造される。

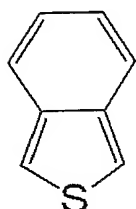
【化5】



(3)

〔式中、芳香環上で水素が結合している位置は置換基で置換されていてもよい。〕

【化6】



(4)

〔式中、芳香環上で水素が結合している位置は置換基で置換されていてもよい。〕

【0026】

具体的には、式(3)または式(4)で示される化合物にスルホン化剤を反応させることにより、同一反応液中でカチオン重合反応及びスルホン化反応が起こり、先ず式(1)で示されるモノマー単位(M^+ が H^+ のもの)と式(2)で示されるモノマー単位からなる共重合体が生成する。この共重合体を水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウムなどのアルカリで中和するが、このときのpHの調整範囲は3~7が好ましく、4~6がより好ましい。また、重合反応で得られた重合体のスルホン酸基部分をイオン交換により一旦H型とした後に、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウムなどのアルカリで中和してもよい。このときのpHの調整範囲は3~7が好ましく、4~6がより好ましい。中和した溶液から水を蒸発させることにより本発明の陽極バッファ層用重合体を得ることができる。

【0027】

本発明の第2の形態は、本発明の第1の形態である陽極バッファ層用重合体を含む陽極バッファ層塗布用溶液である。

本発明の陽極バッファ層用重合体は水溶性であるため、陽極バッファ層塗布用溶液の溶媒は水が好ましい。陽極バッファ層塗布用溶液における重合体の割合は0.1~10質量%が好ましく、0.5~5%がより好ましい。

【0028】

また、陽極バッファ層用溶液は、基板への濡れ性を上げる目的で界面活性剤を含んでもよい。使用可能な界面活性剤としては、カルボン酸塩、 α -オレフィンスルホン酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキル硫酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩、アルキル硫酸トリエタノールアミン等のアニオン系界面活性剤、アルキルトリメチルアンモニウム塩、ジアルキルジメチルアンモニウムクロリド、アルキルピリジニウムクロリド等のカチオン系界面活性剤、アルキルカルボキシベタイン等の両性イオン系界面活性剤、カルボン酸ジエタノールアミド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル等の非イオン系界面活性剤などを例示することができる。界面活性剤の添加割合は、本発明の陽極バッファ層用重合体に対して、0~100質量%が好ましく、0~30質量%がより好ましい。

【0029】

また、同様に基板への濡れ性を上げる目的で、陽極バッファ層塗布用溶液はメタノール、エタノール、2-プロパノール等の極性の高いアルコールを含んでもよい。アルコールの添加割合は、陽極バッファ層塗布用水溶液全体に対して0~60質量%が好ましい。

【0030】

陽極バッファ層塗布用溶液は、更にスピンコート法、インクジェット法、印刷法など

の成膜プロセスに応じ、それぞれのプロセスに必要な各種の添加剤、例えば増粘剤、分散剤、消泡剤、酸化防止剤、光安定剤、滑剤などを含んでいてもよい。

【0031】

本発明の第3の形態は、本発明の第1の形態である陽極バッファ層用重合体を含む陽極バッファ層を有する有機発光素子である。

本発明の有機発光素子における陽極バッファ層は、陽極が形成された基板上に、本発明の第2の形態である陽極バッファ層塗布用溶液を塗布し、その後溶媒を乾燥除去することにより形成することができる。塗布方法としては、スピンコート法、インクジェット法、印刷法、スプレー法、ディスペンサー法などを用いることができる。陽極バッファ層の厚さは10～200nmが好ましく、20～100nmがより好ましい。

【0032】

本発明の有機発光素子における発光層、ホール輸送層、及び電子輸送層に使用する化合物としては、低分子化合物及び高分子化合物のいずれをも使用することができる。本発明の陽極バッファ層が高分子化合物であり、素子作製プロセスを簡素化するという観点から高分子化合物を使用することが好ましい。

【0033】

本発明の有機発光素子の発光層を形成する発光材料としては、大森裕：応用物理、第70巻、第12号、1419-1425頁（2001年）に記載されている低分子発光材料及び高分子発光材料などを例示することができる。この中でも、特に燐光発光材料は発光効率が高い点で好ましい。また、高分子系発光材料は素子作製プロセスが簡素化されるという点で好ましい。従って、燐光発光性高分子化合物は更に好ましい。

【0034】

本発明の有機発光素子の発光層として使用される燐光発光性高分子化合物としては、室温で燐光を発する高分子化合物であればその構造は特に限定はされない。具体的な高分子構造の最初の例としては、ポリ(p-フェニレン)類、ポリ(p-フェニレンビニレン)類、ポリフルオレン類、ポリチオフェン類、ポリアニリン類、ポリピロール類、ポリピリジン類などの共役系高分子構造を骨格とし、これに燐光発光部位（代表的なものとしては、後述の遷移金属錯体または希土類金属錯体の一価基または二価基を例示できる）が結合した高分子構造を挙げることができる。これらの高分子構造において、燐光発光部位は主鎖に組み込まれていても側鎖に組み込まれていてもよい。

【0035】

燐光発光性高分子化合物の高分子構造の別の例としては、ポリビニルカルバゾール、ポリシラン類などの非共役系高分子構造を骨格とし、これに燐光発光部位が結合した高分子構造を挙げることができる。これらの高分子構造において、燐光発光部位は主鎖に組み込まれていても側鎖に組み込まれていてもよい。

燐光発光性高分子化合物の高分子構造の更に別の例としては、燐光発光部位を有する dendritic を挙げることができる。この場合、燐光発光部位は dendritic の中心核、分岐部分、末端部分のいずれの部分に組み込まれていてもよい。

【0036】

また、上記の高分子構造においては、共役系または非共役系の骨格に結合した燐光発光部位から燐光が発せられるものであるが、共役系または非共役系の骨格自体から燐光が発せられるものであってもよい。本発明の有機発光素子に用いられる燐光発光性高分子化合物としては、材料設計に自由度がある点、燐光発光を得ることが比較的容易な点、合成が容易な点、溶媒への溶解性が高く塗布溶液の調製が容易な点などから、非共役系高分子構造を骨格とし、これに燐光発光部位が結合した高分子（以下、非共役系燐光発光性高分子と呼ぶ。）が好ましい。

【0037】

上記の非共役系燐光発光性高分子は、燐光発光性部位とキャリア輸送性部位から構成されるが、代表的な高分子構造としては図2に示すように、燐光発光性部位とキャリア輸送性部位の結合状態によって、（1）燐光発光性部位とキャリア輸送性部位とが共に高分子

の主鎖内にある場合、(2) 燐光発光性部位は高分子の側鎖にありキャリア輸送性部位は高分子の主鎖内にある場合、(3) 燐光発光性部位は高分子の主鎖内にあり、キャリア輸送性部位は高分子の側鎖にある場合、(4) 燐光発光性部位とキャリア輸送性部位が共に高分子の側鎖にある場合を例示することができる。また、上記の高分子構造は架橋構造を有していてもよい。

【0038】

上記の非共役系燐光発光性高分子は、燐光発光性部位として2種類以上のものを有していてもよく(それぞれ主鎖内にあっても側鎖にあってもよい)、また、キャリア輸送性部位として2種類以上のものを有していてもよい(それぞれ主鎖内にあっても側鎖にあってもよい)。

上記の非共役系燐光発光性高分子の分子量は、重量平均分子量で1000~100000が好ましく、5000~50000がより好ましい。

上記の燐光発光性部位としては、室温で燐光を発光する化合物の一価基または二価基以上の多価基を用いることができるが、遷移金属錯体または希土類金属錯体の一価基または二価基が好ましい。上記の遷移金属錯体に使用される遷移金属は、周期律表の第一遷移元素系列、すなわち原子番号21のScから30のZnまで、第二遷移元素系列、すなわち原子番号39のYから48のCdまで、第三遷移元素系列、すなわち原子番号72のHfから80のHgまでを含む。また、上記の希土類金属錯体に使用される希土類金属は、周期律表のランタノイド系列すなわち原子番号57のLaから71のLuまでを含む。

【0039】

また、上記の遷移金属錯体及び希土類金属錯体に使用できる配位子としては、G. Wilkinson (Ed.), *Comprehensive Coordination Chemistry* (Plenum Press, 1987)、山本明夫「有機金属化学—基礎と応用—」(裳華房、1982)に記載の配位子などを例示することができる。中でも、ハロゲン配位子、含窒素ヘテロ環配位子(フェニルピリジン系配位子、ベンゾキノリン系配位子、キノリノール系配位子、ピピリジル系配位子、ターピリジン系配位子、フェナントロリン系配位子等)、ジケトン配位子(アセチルアセトン配位子、ジピバロイルメタン配位子等)、カルボン酸配位子(酢酸配位子等)、リン配位子(トリフェニルホスフィン系配位子等、亜リン酸エステル系配位子等)、一酸化炭素配位子、イソニトリル配位子、及びシアノ配位子が好ましい。また、1つの金属錯体に複数の配位子を含んでいてもよい。また、上記の金属錯体として二核錯体あるいは多核錯体を使用することもできる。

【0040】

上記のキャリア輸送性部位としては、ホール輸送性化合物、電子輸送性化合物またはホール及び電子の両方を輸送するバイポーラー性化合物の一価基または二価基以上の多価基を用いることができる。ホール輸送性のキャリア輸送部位としては、カルバゾール、トリフェニルアミン、TPD(N, N'-ジフェニル-N, N'-(3-メチルフェニル)-1, 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミン)の一価基または二価基などを例示することができる。また、電子輸送性のキャリア輸送性部位としては、Alq₃(トリスアルミニウムキノリノール)などのキノリノール誘導体金属錯体、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、トリアジン誘導体の一価基または二価基などを例示することができる。また、バイポーラー性のキャリア輸送部位としては、CBP(4, 4'-N, N'-ジカルバゾール-ビフェニル)の一価基または二価基などを例示することができる。

【0041】

本発明の有機発光素子においては、上記の燐光発光性高分子化合物のみで発光層を形成することができる。また、燐光発光性高分子化合物のキャリア輸送性を補うために他のキャリア輸送性化合物を混合して組成物とし、これで発光層を形成することもできる。すなわち、燐光発光性高分子化合物がホール輸送性の場合には電子輸送性化合物を混合することができ、また燐光発光性高分子化合物が電子輸送性の場合にはホール輸送性化合物を混

合することができる。ここで、燐光発光性高分子化合物に混合するキャリア輸送性化合物は低分子化合物及び高分子化合物のいずれでもよい。

【0042】

上記の燐光発光性高分子化合物に混合することができる低分子のホール輸送性化合物としては、TPD (N, N'-ジフェニル-N, N'-(3-メチルフェニル)-1, 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミン)、 α -NPD (4, 4'-ビス [N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ] ビフェニル)、m-MTDATA (4, 4', 4''-トリス (3-メチルフェニルフェニルアミノ) トリフェニルアミン) などのトリフェニルアミン誘導体を始めとする既知のホール輸送材料を例示することができる。また、上記の燐光発光性高分子化合物に混合することができる高分子のホール輸送性化合物としては、ポリビニルカルバゾール、トリフェニルアミン系の低分子化合物に重合性官能基を導入して高分子化したもの、例えば特開平 8-157575 号公報に開示されているトリフェニルアミン骨格の高分子化合物などを例示することができる。

【0043】

一方、上記の燐光発光性高分子化合物に混合することができる低分子の電子輸送性化合物としては、Alq₃ (トリスアルミニウムキノリノール) などのキノリノール誘導体金属錯体、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、トリアジン誘導体などを例示することができる。また、上記の燐光発光性高分子化合物に混合することができる高分子の電子輸送性化合物としては、上記の低分子の電子輸送性化合物に重合性官能基を導入して高分子化したもの、例えば特開平 10-1665 号公報に開示されているポリPBDなどを例示することができる。

【0044】

また、上記の燐光発光性高分子化合物を成膜して得られる膜の物性等を改良する目的で、燐光発光性高分子化合物の発光特性に直接的には関与しない高分子化合物を混合して組成物とし、これを発光材料として用いることもできる。一例を挙げると、得られる膜に柔軟性を付与するために、PMMA (ポリメチルメタクリレート) やポリカーボネートを混合することができる。

発光層の厚さは 1 nm ~ 1 μ m が好ましく、5 nm ~ 300 nm がより好ましく、10 nm ~ 100 nm がより一層好ましい。

【0045】

本発明の有機発光素子において、ホール輸送層を形成するホール輸送材料としては、TPD (N, N'-ジメチル-N, N'-(3-メチルフェニル)-1, 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミン)、 α -NPD (4, 4'-ビス [N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ] ビフェニル)、m-MTDATA (4, 4', 4''-トリス (3-メチルフェニルフェニルアミノ) トリフェニルアミン) などのトリフェニルアミン誘導体、ポリビニルカルバゾールなどの既知の低分子系ホール輸送材料を例示することができる。また、高分子系ホール輸送材料も使用することができ、トリフェニルアミン系の低分子化合物に重合性官能基を導入して高分子化したもの、例えば特開平 8-157575 号公報に開示されているトリフェニルアミン骨格の高分子化合物、更にポリパラフェニレンビニレン、ポリジアルキルフルオレンなどの高分子材料を例示することができる。これらのホール輸送材料は単独で用いることもできるが、異なるホール輸送材料と混合または積層して用いてもよい。ホール輸送層の厚さは 1 nm ~ 5 μ m が好ましく、5 nm ~ 1 μ m がより好ましく、10 nm ~ 500 nm がより一層好ましい。

【0046】

本発明の有機発光素子において、電子輸送層を形成する電子輸送材料としては、Alq₃ (トリスアルミニウムキノリノール) などのキノリノール誘導体金属錯体、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、トリアジン誘導体などの既知の低分子系電子輸送材料を例示することができる。また、高分子系電子輸送材料も使用することができ、上記の低分子の電子輸送性化合物に重合性官能基を導入して高分子化したもの、例えば特開平 10-1665 号公報に開示されているポリPBDなどを例示するこ

とができる。これらの電子輸送材料は単独で用いることもできるが、異なる電子輸送材料及と混合または積層して用いてもよい。電子輸送層の厚さとしては $1\text{ nm} \sim 5\text{ }\mu\text{ m}$ が好ましく、 $5\text{ nm} \sim 1\text{ }\mu\text{ m}$ がより好ましく、 $10\text{ nm} \sim 500\text{ nm}$ がより一層好ましい。

【0047】

上記の発光層に用いられる燐光発光性高分子化合物、ホール輸送層に用いられるホール輸送材料及び電子輸送層に用いられる電子輸送材料は、それぞれ単独で各層を形成するほかに、高分子材料をバインダとして各層を形成することもできる。これに使用される高分子材料としては、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリスルホン、ポリフェニレンオキサイドなどを例示することができる。

上記の発光層、ホール輸送層及び電子輸送層法は、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、スパッタリング法、インクジェット法、スピンドーティング法、ディップコーティング法、印刷法、スプレー法、ディスペンサー法などにより形成することが可能であるが、低分子化合物の場合は主として抵抗加熱蒸着法及び電子ビーム蒸着法が用いられ、高分子化合物の場合は主にインクジェット法、スピンドーティング法が用いられる。

【0048】

また、ホールが発光層を通過することを抑え、発光層内で電子と効率よく再結合させる目的で、発光層の陰極側に隣接してホール・ブロック層が設けられてもよい。これには発光材料より HOMO 準位の深い化合物を用いることができ、トリアゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、フェナントロリン誘導体、アルミニウム錯体などを例示することができる。

更に、励起子（エキシトン）が陰極金属で失活することを防ぐ目的で、発光層の陰極側に隣接してエキシトン・ブロック層が設けられてもよい。これには発光材料より励起三重項エネルギーの大きな化合物を用いることができ、トリアゾール誘導体、フェナントロリン誘導体、アルミニウム錯体などを例示することができる。

【0049】

本発明の有機発光素子に使用できる陽極材料としては、ITO（酸化インジウムスズ）、酸化錫、酸化亜鉛、ポリチオフェン、ポリピロール、ポリアニリンなどの導電性高分子などの既知の透明導電材料を例示することができる。この透明導電材料による電極の表面抵抗は $1 \sim 50\text{ }\Omega/\square$ （オーム/スクエアー）であることが好ましい。これらの陽極材料の成膜方法としては、電子ビーム蒸着法、スパッタリング法、化学反応法、コーティング法などを用いることができる。陽極の厚さは $50 \sim 300\text{ nm}$ が好ましい。

【0050】

本発明の有機発光素子の陰極材料としては、仕事関数が低く且つ化学的に安定なものが使用され、Al、MgAg合金、AlLiやAlCaなどのAlとアルカリ金属の合金などの既知の陰極材料を例示することができるが、化学的安定性を考慮すると仕事関数は 2.9 eV 以上であることが好ましい。これらの陰極材料の成膜方法としては、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法などを用いることができる。陰極の厚さは $10\text{ nm} \sim 1\text{ }\mu\text{ m}$ が好ましく、 $50 \sim 500\text{ nm}$ がより好ましい。

【0051】

また、陰極から有機層への電子注入障壁を下げて電子の注入効率を上げる目的で、陰極バッファ層として、陰極より低仕事関数の金属層を陰極と陰極に隣接する有機層の間に挿入してもよい。このような目的に使用できる低仕事関数の金属としては、アルカリ金属ではNa、K、Rb、Csを、アルカリ土類金属ではSr、Baを、希土類金属ではPr、Sm、Eu、Yb等を挙げることができる。また、陰極より低仕事関数であれば、合金または金属化合物も使用することができる。これらの陰極バッファ層の成膜方法としては、蒸着法やスパッタ法などを用いることができる。陰極バッファ層の厚さは $0.05 \sim 50\text{ nm}$ が好ましく、 $0.1 \sim 20\text{ nm}$ がより好ましく、 $0.5 \sim 10\text{ nm}$ がより一層好ましい。

【0052】

更に、陰極バッファ層は、上記の低仕事関数の物質と電子輸送材料の混合物として形成することもできる。なお、ここで用いられる電子輸送材料は前述の電子輸送層に用いら

れる有機化合物を用いることができる。この場合の成膜方法としては共蒸着法を用いることができる。また、溶液による塗布成膜が可能な場合は、スピンコーティング法、ディップコーティング法、インクジェット法、印刷法、スプレー法、ディスペンサー法などの成膜方法を用いることができる。この場合の陰極バッファ層の厚さは0.1~100 nmが好ましく、0.5~50 nmがより好ましく、1~20 nmがより一層好ましい。

本発明に係る有機発光素子の基板としては、発光材料の発光波長に対して透明な絶縁性基板が使用でき、ガラスのほか、PET（ポリエチレンテレフタレート）やポリカーボネートを始めとする透明プラスチックなどの既知の材料が使用できる。

【実施例】

【0053】

以下に本発明について、代表的な合成例及び実施例を示し、さらに具体的に説明する。なお、これらは説明のための単なる例示であって、本発明はこれらに何ら制限されるものではない。

下記の例において分析に使用した装置は以下の通りである。また、試薬類は特に断らない限り、市販品（特級）を精製することなく使用した。

【0054】

1) ^1H -NMR

日本電子（株）製 JNM EX270、270 MHz、
溶媒：重クロロホルム。

2) 元素分析装置

LECO社製 CHNS-932型。

3) GPC測定（分子量測定）

カラム：Shodex KF-G+KF804L+KF802+KF801、
溶離液：テトラヒドロフラン（THF）、
温度：40℃、
検出器：RI（Shodex RI-71）。

4) ICP元素分析

島津製作所製 ICPS 8000。

【0055】

合成例1：陽極バッファ層用重合体：ポリ（5-スルホイソチアナフテン-1, 3-イル）（以下、polySITNと略す。）の合成

特開平6-49183の実施例3に開示された方法に従ってスルホン酸基部分がH型の重合体を得た。得られた重合体の1質量%の水溶液100 mlに1 Nの水酸化アンモニウムを3.5 g加えてpHを4.4に調整した。この重合体水溶液から水を蒸発させることにより濃紺色の重合体0.99 gを得た。なお、中和に要したアルカリの量から、式（2）に相当する自己ドーピング型モノマーのモル分率は0.21と計算された。また、この重合体のポリスチレン換算の重量平均分子量は17,200であった（GPC測定による）。

【0056】

合成例2：燐光発光性モノマー：[6-（4-ビニルフェニル）-2, 4-ヘキサンジオナート]ビス（2-フェニルピリジン）イリジウム（III）（以下、IrPAと略す）の合成

特開2003-113246号公報に開示された方法に従って合成を行い、IrPAを得た。

【0057】

合成例3：燐光発光性共重合体：poly（N-ビニルカルバゾール-co-[6-（4-ビニルフェニル）-2, 4-ヘキサンジオナート]ビス（2-フェニルピリジン）イリジウム（III））（以下、poly（VCz-co-IrPA）と略す）の合成

発光機能を有する単位としてIrPA、ホール輸送機能を有する単位としてN-ビニルカルバゾールを含有する発光材料として上記共重合体を合成した。

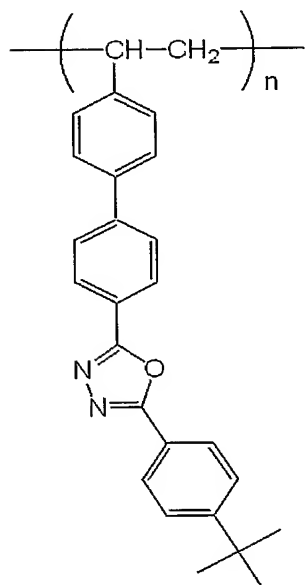
N-ビニルカルバゾール1.55 g（8.0 mmol）、Ir（ppy）₃ [1-（StMe）

—acac] 29 mg (0.04 mmol)、AIBN 13 mg (0.08 mmol) を脱水トルエン 40 ml に溶解させ、さらに 1 時間アルゴンを吹き込んだ。この溶液を 80℃まで昇温し、重合反応を開始させ、そのまま 8 時間攪拌した。冷却後、反応液をメタノール 250 ml 中に滴下して重合物を沈殿させ、ろ過により回収した。さらに、回収した重合物をクロロホルム 25 ml に溶解させ、この溶液をメタノール 250 ml 中に滴下して再沈殿させることにより精製した後、60℃で 12 時間真空乾燥させることにより目的物である poly (VCz-co-IrPA) 1.14 g を得た (回収率 72%)。この重合体のポリスチレン換算の数平均分子量は 4800、重量平均分子量は 11900 であった (GPC 測定による)。また、燐光発光性部位である Ir 錯体部分の含有量は 0.62 mol % であった (ICP 元素分析による)。

【0058】

合成例 4：電子輸送性高分子化合物：poly PBD (下記構造式 (5)) の合成

【化 7】



(5)

特開平 10-1665 号公報に開示された方法に従って合成を行い、poly TPD を得た。ポリスチレン換算の数平均分子量は 32400、重量平均分子量は 139100 であった (GPC 測定による)。

【0059】

実施例 1：自己ドープ型ポリイソチアナフテン薄膜の表面抵抗と導電率

合成例 1 で合成した poly SITN の 1 質量%水溶液を作製し、ガラス基板上にスピンコーター (3000 rpm、60 秒) で塗布し、140℃で 30 分乾燥を行った。その結果、膜厚 30 nm の薄膜が得られた。Megaresta Model HT-301 (シシド静電気社製) を用いてこの薄膜の表面抵抗を測定したところ $6 \times 10^5 \Omega/\square$ であった。この値から導電率は 1.8 S/cm と計算された。

【0060】

実施例 2：自己ドープ型ポリイソチアナフテンを陽極バッファ層とする有機発光素子 (蛍光発光) の作製と発光特性

25 mm 角のガラス基板の一方の面に、陽極となる幅 4 mm の 2 本の ITO 電極がストライプ状に形成された ITO (酸化インジウム錫) 付き基板 (ニッポ電機製) を用いて有機発光素子を作製した。はじめに、陽極バッファ層を形成するための塗布溶液を調製した。すなわち、合成例 1 で合成した poly SITN の 1 質量%水溶液を作製した。なお、この塗布溶液の pH は 4.4 であった。この塗布溶液を ITO 付き基板上にスピンコーター (3000 rpm、30 秒) で塗布し、140℃で 30 分乾燥を行い、陽極バッファ層を形成した。得られた陽極バッファ層の膜厚は約 30 nm であった。次に、発光層を形

成するための塗布溶液を調製した。すなわち、ポリ(2-メトキシ-5-(2'-エチルヘキシルオキシ)-1,4-フェニレンビニレン)(以下、MEH-PPVと略す。)(American Dye Source Inc.製, ADS100RE) 45mgをテトラヒドロフラン(和光純薬工業製、特級) 2955mgに溶解し、得られた溶液を孔径 $0.2\mu\text{m}$ のフィルターでろ過して塗布溶液とした。次に、陽極バッファ層上に、調製した塗布溶液をスピンコート法により、回転数3000rpm、塗布時間30秒の条件で塗布し、 140°C で30分間乾燥を行い、発光層を形成した。得られた発光層の膜厚は約 100nm であった。次に発光層を形成した基板を蒸着装置内に載置し、カルシウムを蒸着速度 0.1nm/s で 25nm の厚さに蒸着し、続いて、陰極としてアルミニウムを蒸着速度 1nm/s で 250nm の厚さに蒸着した。なお、セシウムとアルミニウムの層は、陽極の延在方向に対して直交する2本の幅3mmのストライプ状に形成した。最後に、アルゴン雰囲気中において、陽極と陰極とにリード線を取り付けて、1枚の基板当たり縦 4mm ×横 3mm の有機発光素子を4個作製した。(株)アドバンテスト社製プログラマブル直流電圧/電流源TR6143を用いて上記有機EL素子に電圧を印加して発光させ、その発光輝度を(株)トプコン社製輝度計BM-8を用いて測定した。その結果、最大輝度、最大外部量子効率、初期輝度 100cd/m^2 からの輝度半減寿命は表1のようになった(1枚の基板中の4個の素子の平均値)。

【0061】

実施例3: 自己ドーパ型ポリイソチアナフテンを陽極バッファ層とする有機発光素子(燐光発光)の作製と発光特性

発光層の形成を以下のようにする以外は実施例2と同様にして有機発光素子を作製し、発光特性の評価を行った。すなわち、合成例3で合成したpoly(VCz-co-IRPA) 63.0mg、合成例4で合成したpolyPBD 27.0mgをトルエン(和光純薬工業製、特級) 2910mgに溶解し、得られた溶液を孔径 $0.2\mu\text{m}$ のフィルターでろ過して塗布溶液とした。この塗布溶液を陽極バッファ層上にスピンコーター(3000rpm、30秒)で塗布し、 140°C で30分乾燥を行い、発光層を形成した。得られた発光層の膜厚は約 80nm であった。その結果、最大輝度、最大外部量子効率、初期輝度 100cd/m^2 からの輝度半減寿命は表1のようになった(1枚の基板中の4個の素子の平均値)。

【0062】

比較例1: ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフエン)・ポリスチレンスルホン酸の混合体を陽極バッファ層とする有機発光素子(蛍光発光)の作製と発光特性

陽極バッファ層の形成を以下のようにする以外は実施例2と同様にして有機発光素子を作製し、発光特性の評価を行った。すなわち、陽極バッファ層を形成するための塗布溶液としてポリ(3,4-エチレンジオキシチオフエン)・ポリスチレンスルホン酸混合体の水溶液(バイエル社製、商品名「Baytron CH8000」)を使用した。なお、この塗布溶液は固形分濃度が2.8質量%であるが、この濃度が1質量%になるように水で希釈したときのpHは2.4であった。この塗布溶液をITO付き基板上にスピンコーター(3500rpm、40秒)で塗布し、 140°C で30分乾燥を行い、陽極バッファ層を形成した。得られた陽極バッファ層の膜厚は約 50nm であった。その結果、最大輝度、初期輝度 100cd/m^2 からの輝度半減寿命は表1のようになった(1枚の基板中の4個の素子の平均値)。

【0063】

比較例2: ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフエン)・ポリスチレンスルホン酸の混合体を陽極バッファ層とする有機発光素子(燐光発光)の作製と発光特性

発光層の形成を以下のようにする以外は比較例1と同様にして有機発光素子を作製し、発光特性の評価を行った。すなわち、合成例3で合成したpoly(VCz-co-IRPA) 63.0mg、合成例4で合成したpolyPBD 27.0mgをトルエン(和光純薬工業製、特級) 2910mgに溶解し、得られた溶液を孔径 $0.2\mu\text{m}$ のフィルターでろ過して塗布溶液とした。この塗布溶液を陽極バッファ層上にスピンコーター(3000rpm、30秒)で塗布し、 140°C で30分乾燥を行い、発光層を形成した。得られた発光層の膜厚は

約 80 nm であった。その結果、最大輝度、最大外部量子効率、初期輝度 100 cd/m² からの輝度半減寿命は表 1 のようになった（1 枚の基板中の 4 個の素子の平均値）。

【0064】

比較例 3：自己ドープ型ポリアニリンを陽極バッファ層とする有機発光素子（蛍光発光）の作製と発光特性

陽極バッファ層の形成を以下のようにする以外は実施例 2 と同様にして有機発光素子を作製し、発光特性の評価を行った。すなわち、陽極バッファ層を形成するための塗布溶液としてポリ（アニリンスルホンニックアシッド）（以下、polySAN と略す）水溶液（Sigma-Aldrich Japan K.K. 製）を使用した。なお、この塗布溶液は固形分濃度が 5 質量% であるが、この濃度が 1 質量% になるように水で希釈したときの pH は 2.5 であった。この塗布溶液を ITO 付き基板上にスピンコーター（5000 rpm、30 秒）で塗布し、140℃ で 30 分乾燥を行い、陽極バッファ層を形成した。得られた陽極バッファ層の膜厚は約 60 nm であった。その結果、最大輝度、初期輝度 100 cd/m² からの輝度半減寿命は表 1 のようになった（1 枚の基板中の 4 個の素子の平均値）。

【0065】

比較例 4：自己ドープ型ポリアニリンを陽極バッファ層とする有機発光素子（燐光発光）の作製と発光特性

発光層の形成を以下のようにする以外は比較例 3 と同様にして有機発光素子を作製し、発光特性の評価を行った。すなわち、合成例 3 で合成した poly(VCz-co-IrPA) 63.0mg、合成例 4 で合成した polyPBD 27.0mg をトルエン（和光純薬工業製、特級）2910mg に溶解し、得られた溶液を孔径 0.2 μm のフィルターでろ過して塗布溶液とした。この塗布溶液を陽極バッファ層上にスピンコーター（3000 rpm、30 秒）で塗布し、140℃ で 30 分乾燥を行い、発光層を形成した。得られた発光層の膜厚は約 80 nm であった。その結果、最大輝度、最大外部量子効率、初期輝度 100 cd/m² からの輝度半減寿命は表 1 のようになった（1 枚の基板中の 4 個の素子の平均値）。

【0066】

【表 1】

実施例 比較例	陽極バッファ層	発光層	最高輝度 (cd/m ²)	最高外部量 子効率(%)	輝度半減寿命 (hr@100cd/m ²)
実施例 2	polySITN	MEH-PPV	7,200	2.1	3,900
実施例 3	polySITN	poly(VCz-co-IrPA) +polyPBD	14,700	5.2	48
比較例 1	Baytron CH8000	MEH-PPV	4,100	1.4	1,900
比較例 2	Baytron CH8000	poly(VCz-co-IrPA) +polyPBD	8,300	3.7	22
比較例 3	polySAN	MEH-PPV	3,800	1.2	1,800
比較例 4	polySAN	poly(VCz-co-IrPA) +polyPBD	6,500	3.1	17

【産業上の利用可能性】

【0067】

本発明の陽極バッファ層用重合体を用いることにより、外来ドーパントによる発光層の劣化が抑えられ、且つ高効率発光を兼ね備えた有機発光素子を提供することが可能とな

る。

また、陽極バッファ層形成用の塗布液の酸性度が低いため、有機発光素子の生産プロセスへの負荷が軽くなる効果もある。

【図面の簡単な説明】

【0068】

【図1】本発明の有機発光素子例の断面図である。

【図2】本発明の有機発光素子に用いられる非共役系燐光発光性高分子の高分子構造の例である。

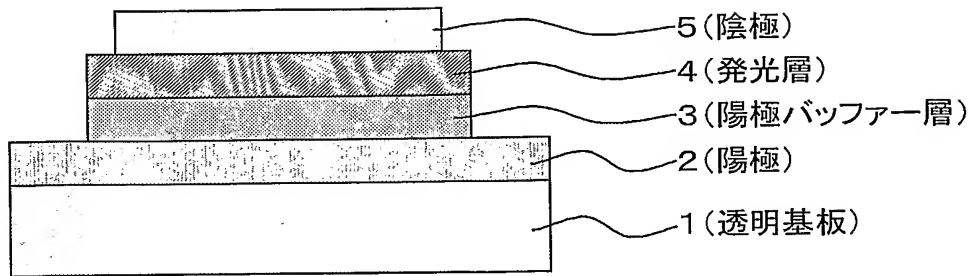
【符号の説明】

【0069】

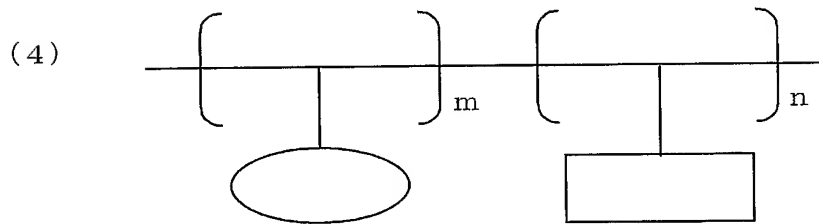
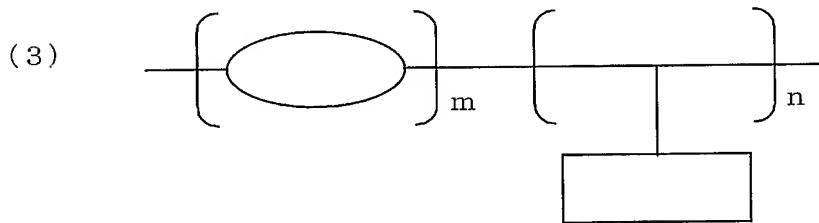
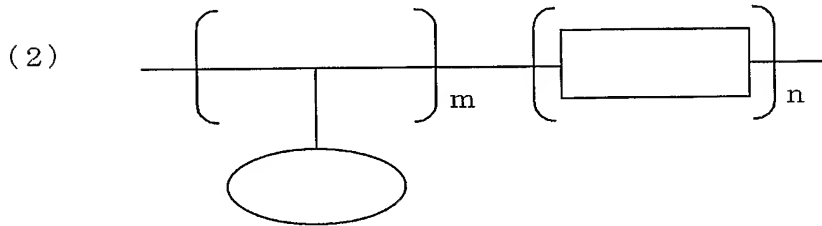
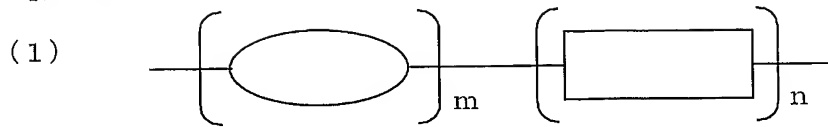
- 1 透明基板
- 2 陽極
- 3 陽極バッファ層
- 4 発光層
- 5 陰極


【書類名】 図面

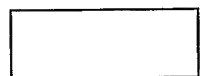
【図 1】



【図 2】



 : 発光発光性部位

 : キャリア輸送性部位

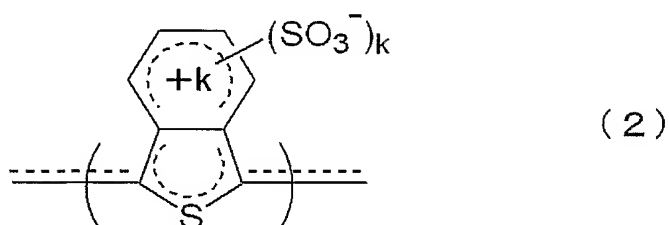
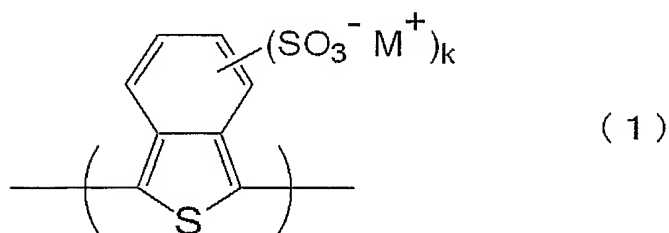
【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 外来ドーパントによる発光層劣化の問題を解消した陽極バッファ層用自己ドーピング型導電性高分子を提供する。

【解決手段】 1 質量水溶液における pH が 3 ～ 7 である、式 (1) 及び／または式 (2)

【化 1】



〔式中、式中、 M^+ は水素イオン、アルカリ金属イオンまたは第4級アンモニウムイオンを表わし、 k は1または2であり、 $+k$ は正電荷の数を表わし、芳香環上の水素が結合している位置は置換基で置換されていてもよい。〕で示されるモノマー単位を含む自己ドーピング型導電性高分子からなる有機発光素子の陽極バッファ層用重合体、その重合体を含む有機発光素子の陽極バッファ層塗布用溶液、及び前記重合体を用いた陽極バッファ層を有する有機発光素子。

【選択図】 なし



認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2003-410097
受付番号	50302024762
書類名	特許願
担当官	第四担当上席 0093
作成日	平成 15 年 12 月 15 日

< 認定情報・付加情報 >

【特許出願人】

【識別番号】	000002004
【住所又は居所】	東京都港区芝大門 1 丁目 13 番 9 号
【氏名又は名称】	昭和電工株式会社

【代理人】

【識別番号】	100117732
【住所又は居所】	東京都中央区日本橋人形町 2 丁目 2 番 6 号 堀口 第二ビル 7 階 大家特許事務所
【氏名又は名称】	小澤 信彦

【代理人】

【識別番号】	100121050
【住所又は居所】	東京都中央区日本橋人形町 2 丁目 2 番 6 号 堀口 第 2 ビル 7 階 大家特許事務所
【氏名又は名称】	林 篤史

【代理人】

【識別番号】	100081086
【住所又は居所】	東京都中央区日本橋人形町 2 丁目 2 番 6 号 堀口 第 2 ビル 7 階 大家特許事務所
【氏名又は名称】	大家 邦久

特願 2 0 0 3 - 4 1 0 0 9 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 2 0 0 4]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 2 7 日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都港区芝大門 1 丁目 1 3 番 9 号
氏 名	昭和電工株式会社